

---

第 6 回 赤崎記念研究センターシンポジウム

---

主催：名古屋大学 赤崎記念研究センター  
財団法人 日比科学技術振興財団

協賛：名古屋大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー  
日本学術振興会「ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会」  
名城大学窒化物半導体研究センター  
名古屋大学 21 世紀 COE プログラム「先端プラズマ科学が拓くナノ情報デバイス」

1. 日時：平成 18 年 10 月 19 日（木） 13:30 - 17:10PM  
~ 20 日（金）9:50 - 12:00AM  
(尚、10 月 20 日（金）14:00 から記念式典・記念講演会・祝賀会が開催されます)
2. 場所：名古屋大学 I B 電子情報館 大講義室  
名古屋市千種区不老町 1 (名古屋市営地下鉄名城線 名古屋大学駅下車)
3. テーマ：「窒化物半導体研究の新展開：新規デバイスの創出をめざして」
4. プログラム

**Thursday, October 19, 13:30PM~17:10PM**

**[1] Physical Properties and Characterization**

13:35-14:20 "Electronic structure of nitride surfaces"

*C. Van de Walle (UC-SB)*

14:20- 14:40; "Analysis of In distribution in GaInN/GaN multilayer structures  
by X-ray CTR scattering"

*M. Tabuchi and Y. Takeda (Nagoya Univ.)*

14:40- 15:00 "Impurity incorporation in N terminated GaN and AlGa<sub>N</sub>"

*N.Sawaki, N.Koide, T.Hikosaka, Y.Honda, and M.Yamaguchi (Nagoya Univ.)*

**[2] Electronic Devices**

15:20-16:05 "GaN HEMTs: The ideal device for mm-wave applications?"

*U. K. Mishra (UC-SB)*

16:05- 16:50 "Development of GaN HEMT, Present status and future trend"

*S. Nakajima, Y. Tateno, A. Kawano, K. Eibihara, N. Ui, H. Sano, N. Miyashita,  
S. Kurachi, H. Yokoyama, T. Tanahashi and S. Sano (Eudyna Devices Inc.)*

16:50-17:10 "Characterization of transient behaviors of AlGa<sub>N</sub>/GaN HEMTs"

*T. Mizutani and A. Kawano (Nagoya University)*

**Friday, October 20, 9:50AM~12:00AM**

**[3] Photonic Devices**

9:50-10:35 "AlN deep-UV LEDs with a wavelength of 210 nm"

*Y. Taniyasu, M. Kasu, and T. Makimoto (NTT)*

10:35- 10:55 "Novel UV devices based on high temperature grown AlGa<sub>N</sub>"

*H. Amano, K. Balakrishnan, M. Iwaya, S. Kamiyama, I. Akasaki,  
T. Noro, T.Takagi, and A. Bandoh (Meijo Univ.)*

10:55- 11:40 "Prospects of group-III nitrides with nonpolar surfaces"

*H.T. Grahn (Paul-Drude-Inst)*

11:40- 12:00 ""Emission from facet structures of III-nitrides"

*H. Miyake, K. Nakao and K. Hiramatsu (Mie Univ)*

- 4 . 連絡先 : 464-8603 名古屋市千種区不老町 名古屋大学工学研究科内  
赤崎記念研究センター  
電話 : 052-789-3321 (坂下) Fax: 052-789-3157

---

## 赤崎記念研究館竣工記念式典・祝賀会

---

- 1 . 日時 平成 18 年 10 月 20 日 (金) 午後 2 時から
- 2 . 場所 赤崎記念研究館  
名古屋大学 I B 電子情報館大講義室  
名古屋大学シンポジオンホール
- 3 . プログラム (予定)
- ・ 記念式典 (午後 2 時から) I B 電子情報館大講義室
  - ・ 記念講演会 (午後 2 時 50 分から) I B 電子情報館大講義室  
"Recent Developments in the III-Nitride Materials"  
窒化物半導体の最近の進展」 Bo Monemar リンシヨピン大学 教授
  - ・ テープカット・施設見学 (午後 4 時から) 赤崎記念研究館
  - ・ 祝賀会 (午後 5 時から) 名古屋大学シンポジオンホール
- 4 . 連絡先 : 464-8603 名古屋市千種区不老町 名古屋大学工学研究科内  
赤崎記念研究センター  
電話 : 052-789-3321 (坂下) Fax: 052-789-3157